



一种锌掺杂的负温度系数单晶硅热敏电阻

巴维真; 陈朝阳^{*}; 丛秀云; 蔡志军; 崔志明

2008-04-02

专利权人 中国科学院新疆理化技术研究所

授权日期 2013-11-27

授权国家 中国

专利类型 发明

摘要

本发明涉及一种锌掺杂的负温度系数单晶硅热敏电阻, 该热敏电阻采用真空气相扩散方法, 将锌原子作为掺杂剂, 掺入n型单晶硅中; 利用锌在n型单晶硅中的杂质补偿性质, 制备出珠状高B值热敏电阻器。该电阻器适用于温度计(如体温计)使用的热敏电阻必须是高B值的元件; 集成电路板上表面贴片技术使用的热敏元件要求采用高B值片式元件; 电动机等设备中, 需要抑制机器启动时较强的浪涌电流, 对设备进行保护; 在各类充电设备中, 需要使用高B值的热敏电阻抑制浪涌电流, 延长电池的寿命。

申请日期 2004-11-05

专利号 ZL200410092027.4

专利状态 授权

申请号 200410092027.4

文献类型 专利条目标识符 <http://ir.tianshanzw.cn/handle/365002/3136>

专题 材料物理与化学研究室

推荐引用方式 巴维真,陈朝阳,丛秀云,等. 一种锌掺杂的负温度系数单晶硅热敏电阻[P]. 2008-04-02.
GB/T 7714

三 条目包含的文件

条目无相关文件。

所有评论 (0)

[\[发表评论/异议/意见\]](#)

暂无评论

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

个性服务

[推荐该条目](#)[★ 保存到收藏夹](#)[📊 查看访问统计](#)[📄 导出为Endnote文件](#)

谷歌学术

[📖 谷歌学术中相似的文章](#)[📖 \[巴维真\]的文章](#)[📖 \[陈朝阳\]的文章](#)[📖 \[丛秀云\]的文章](#)

百度学术

[📖 百度学术中相似的文章](#)[📖 \[巴维真\]的文章](#)[📖 \[陈朝阳\]的文章](#)[📖 \[丛秀云\]的文章](#)

必应学术

[📖 必应学术中相似的文章](#)[📖 \[巴维真\]的文章](#)[📖 \[陈朝阳\]的文章](#)[📖 \[丛秀云\]的文章](#)

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

